



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

**Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)**

ул. Политехническая, д. 26, г. Санкт-Петербург, 194021
Тел. (812) 297-22-45, факс (812) 297-10-17
post@mail.ioffe.ru, <http://www.ioffe.ru>
ОКПО 02698463, ОГРН 1037804006998
ИНН 7802072267, КПП 780201001

26.08.2026 № 01.03-2046
На № _____ от _____

О согласии выступить в качестве ведущей
организации

Председателю совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата
науки, на соискание ученой степени доктора
наук 33.2.018.22, созданного на базе
федерального государственного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена» доктору физико-математических
наук, доценту
Колобову Александру Владимировичу

Уважаемый Александр Владимирович!

В ответ на Ваше обращение федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук сообщает о согласии выступить в качестве ведущей организации по диссертации Микушева Сергея Владимировича «Моделирование и оптические свойства анизотропных полупроводниковых наноструктур», представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Подтверждаем, что соискатель ученой степени не работает в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Соискатель ученой степени также не является руководителем или работником организации - заказчика или исполнителем (соисполнителем) по научно-исследовательским работам, которые ведутся в ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

Отзыв ведущей организации будет направлен в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в автореферат диссертации и для размещения на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», прилагаются..

И.о. директора Института



П.Н. Брунков

Исполнитель: Азбель Александр Юльевич
Тел. (812) 297 50 69
E-mail azbel@mail.ioffe.ru

Сведения о ведущей организации

по диссертации Микушева Сергея Владимировича на тему: «Моделирование и оптические свойства анизотропных полупроводниковых наноструктур» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния, представленной к рассмотрению в диссертационном совете 33.2.018.22 на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена»

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес организации	194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
Веб-сайт	https://www.ioffe.ru
Телефон	+7(812) 297-2245
Адрес электронной почты	post@mail.ioffe.ru

Список основных публикаций сотрудников организации по теме диссертации за последние 5 лет	
1.	Sharov,V; Pavlov,A; Elisayev,I; Moskalev,M; Komarov,S; Novikova,K; Alekseev,P; Kapoor,A; Eymery,J; Durand,C; Tchernycheva,M; Davydov,V; Mukhin,I <u>Nanoscale Welding and Strain-Engineered Photoluminescence of GaN Nanowires</u> . Adv. Opt. Mater., v.13, 30, 2025, ArtNo: #e01821 https://doi.org/10.1002/adom.202501821
2.	Шаров,ВА; Алексеев,ПА; Федоров,ВВ; Мухин,ИС <u>Измерение уровня легирования нитевидных нанокристаллов с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния</u> . ФТТ, т.67, 3, 2025, с. 460 - 463 https://doi.org/10.61011/FTT.2025.03.60256.11-25
3.	Алексеев,ПА; Попов,МЕ <u>Особенности формирования GaAs микродисков методом механической сканирующей зондовой литографии</u> . Письма ЖТФ, т.51, 9, 2025, с. 31 - 34 https://doi.org/10.61011/PJTF.2025.09.60229.20192
4.	Berkovits,VL; Kosobukin,VA; Ulin,VP; Alekseev,PA; Borodin,BR; Soldatenkov,FYu; Nashchekin,AV; Khakhulin,SA; Komkov,OS <u>Creation and plasmon anisotropy spectroscopy of wedge-shaped gold nanoclusters conditioned by GaAs(001) surface</u> . Surf. Sci., v.742, 2024, ArtNo: #122437 https://doi.org/10.1016/j.susc.2023.122437
5.	Borodin,BR; Alekseev,PA; Khayrudinov,V; Ubyivovk,E; Berdnikov,Yu; Sibirev,N; Lipsanen,H <u>P-n junctions in planar GaAs nanowires</u> . CrystEngComm, v.25, 9, 2023, p. 1374 - 1382 http://dx.doi.org/10.1039/d2ce01438f
6.	Shvidchenko,AV; Tudupova,BB; Kuular,VI; Aleksenskii,AE; Trofimuk,AD; Stovpiaga,EYu; Lebedev,VT; Kul'velis,YuV; Yevlampieva,NP; Ivankov,OI; Gundorin,VV; Kurepin,SA; Smirnov,AS; Vul',AYa <u>New Insights into the Crystal Structure of Nanodiamonds Synthesized by Shock Wave Compression of Graphite</u> . Carbon, v.255, 2026, ArtNo: #121541 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2026.121541

7.	Funtikova,AS; Sharov,VA; Dvoretckiaia,LN; Novikova,KN; Eurov,DA; Stovpiaga,EYu; Kurdyukov,DA; Aybush,AV; Koroleva,AV; Zhizhin,EV; Fedorov,VV; Miniv,DV; Mozharov,AM; Mukhin,IS <u>Enhanced second harmonic generation from single spherical mesoporous Si/SiO₂ nanoparticles on gold.</u> Mater. Sci. Semicond. Process., v.204, 2026, ArtNo: #110328 https://doi.org/10.1016/j.mssp.2025.110328
8.	Mastalieva,VA; Neplokh,V; Aybush,A; Stovpiaga,EYu; Eurov,DA; Vinnichenko,M; Karaulov,DA; Kirilenko,DA; Mozharov,A; Sharov,VA; Kolchanov,D; Machnev,A; Golubev,VG; Smirnov,AN; Ginzburg,P; Makarov,S; Kurdyukov,DA; Mukhin,I <u>Second harmonic generation and broad-band photoluminescence in mesoporous Si/SiO₂ nanoparticles.</u> Nanophotonics, v.13, 18, 2024, p. 3299 - 3309 http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2024-0218
9.	Trofimuk,AD; Sharonova,LV; Kidalov,SV; Shvidchenko,AV; Kirilenko,DA; Stovpiaga,EYu; Dideikin,AT <u>Extrastrong aggregates of detonation nanodiamonds: structure and formation.</u> Fuller. Nanotub. Carbon Nanostruct., v.32, 11, 2024, p. 1050 – 1061 https://doi.org/10.1080/1536383X.2024.2367580
10.	Анкудинов,AB; Власов,АС; Дунаевский,МС; Аксенов,ВЮ; Илькив,ИБ; Малевская,AB; Родин,ВД; Щенин,АС; Минтаиров,АМ <u>Вариации электрического потенциала металлической наночастицы на диэлектрике.</u> ФТП, т.59, 10, 2025, с. 620 – 628 https://doi.org/10.61011/FTP.2025.10.62410.8749

И.о. директора Института



П.Н. Брунков